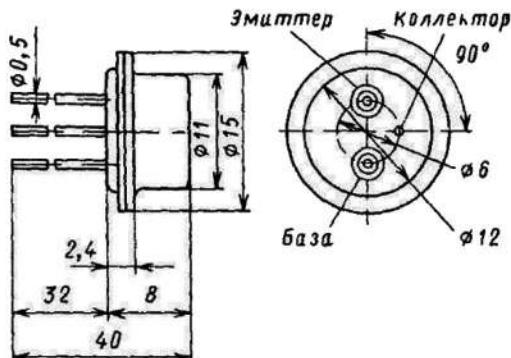


2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM, KT602A, KT602B

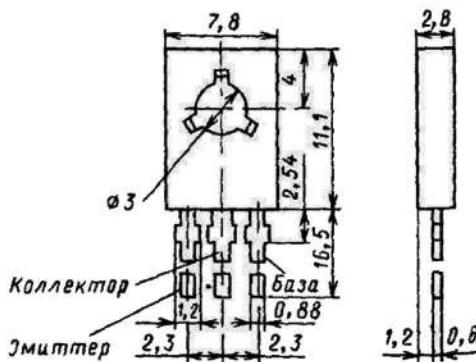
Транзисторы кремниевые планарные *n-p-n* универсальные средней мощности

Предназначены для применения в схемах генерирования и усиления сигналов радиотехнических устройств

Выпускаются в металлокерамическом (2T602A, 2T602B, KT602A, KT602B) и пластмассовом (2T602AM, 2T602BM) корпусах с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе. Масса транзистора не более 5 г в металлокерамическом корпусе и не более 1 г в пластмассовом.



2T602A, 2T602B, KT602A, KT602B



2T602AM, 2T602BM

Электрические параметры

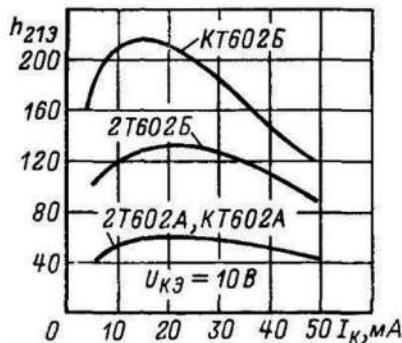
Граничное напряжение при $I_E = 50 \text{ mA}$, $\tau_u = 5 \text{ мкс}$, $f = 2 \text{ кГц}$ не менее	70 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 50 \text{ mA}$, $I_B = 5 \text{ mA}$ не более	3 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 50 \text{ mA}$, $I_B = 5 \text{ mA}$ не более	3 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KB} = 10 \text{ В}$, $I_E = 10 \text{ mA}$:	
2T602A, KT602A, 2T602AM	20–80
2T602B, 2T602BM	50–200
KT602B не менее	50
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{KB} = 10 \text{ В}$, $I_K = 10 \text{ mA}$, $f = 2 \text{ МГц}$ не более	300 пс
Границная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KE} = 10 \text{ В}$, $I_K = 25 \text{ mA}$ не менее	150 МГц
Емкость коллекторного перехода при $U_{KB} = 50 \text{ В}$, $f = 2 \text{ МГц}$ не более	4 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{EB} = 0$, $f = 2 \text{ МГц}$ не более	25 пФ
Обратный ток коллектора при $T = 298 \text{ K}$, $U_{KB} = 120 \text{ В}$ не более	
2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM	10 мкА
KT602A, KT602B	70 мкА
при $T = 398 \text{ K}$, $U_{KB} = 100 \text{ В}$ 2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM не более	50 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер. при $T = 298 \text{ K}$, $U_{KE} = 100 \text{ В}$, $R_{EB} = 10 \text{ Ом}$ не более	
2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM	10 мкА
KT602A, KT602B	100 мкА
при $T = 398 \text{ K}$, $U_{KE} = 80 \text{ В}$, $R_{EB} = 10 \text{ Ом}$ 2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM не более	50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

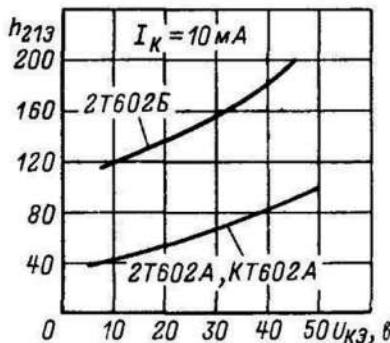
Постоянное напряжение коллектор-база: 2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM:	
при $T < 373 \text{ K}$	120 В
при $T = 423 \text{ K}$	60 В
KT602A, KT602B	
при $T < 343 \text{ K}$	120 В
при $T = 393 \text{ K}$	60 В
Импульсное напряжение коллектор-база: 2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM:	
при $T < 373 \text{ K}$	160 В
при $T = 423 \text{ K}$	80 В
KT602A, KT602B при $T < 343 \text{ K}$	160 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{EB} \leq 1 \text{ кОм}$.	

2T602A 2T602Б		
при $T \leq 373$ К	100 В	
при $T = 423$ К	50 В	
KT602A, KT602Б		
при $T \leq 343$ К	100 В	
при $T = 343$ К	50 В	
Постоянное напряжение эмиттер-база	5 В	
Постоянный ток коллектора	75 мА	
Импульсный ток коллектора при $\tau_i \leq 1$ мкс, $Q \geq 7$	500 мА	
Постоянный ток эмиттера	80 мА	
Постоянная рассеиваемая мощность		
без теплоотвода		
при $T \leq 293$ К	0,85 Вт	
при $T = 398$ К 2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM	0,16 Вт	
при $T = 358$ К KT602A, KT602B	0,2 Вт	
с теплоотводом		
при $T_k \leq 293$ К	2,8 Вт	
при $T_k = 398$ К 2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM	0,55 Вт	
при $T_k = 358$ К KT602A, KT602B	0,65 Вт	
Температура перехода		
2T602A, 2T602B	423 К	
KT602A, KT602B	393 К	
Общее тепловое сопротивление		
переход-корпус	45 К/Вт	
переход-окружающая среда	150 К/Вт	
Температура окружающей среды		
2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM	От 213 до 398 К	
KT602A, KT602B	От 233 до 358 К	

Приложение При постоянной рассеиваемой мощности более 0,85 Вт транзистор необходимо крепить за корпус к теплоотводящей панели



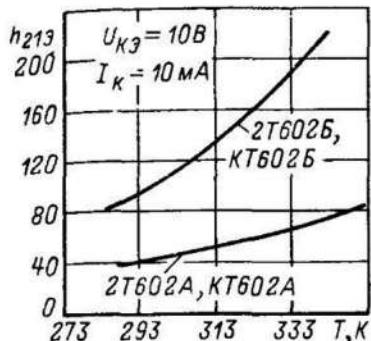
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



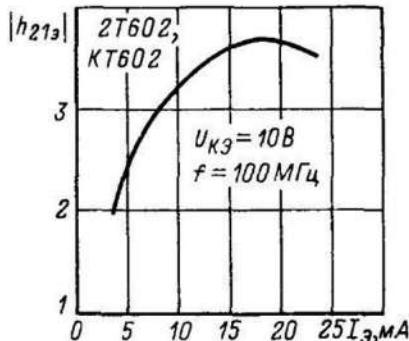
Зависимость статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-эмиттер.

Пайка и изгиб подводящих проводов при монтаже допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса. Радиус закругления при изгибе 1,5–2 мм. Пайку следует производить в течение не более 10 с (температура пайки не должна превышать 533 К).

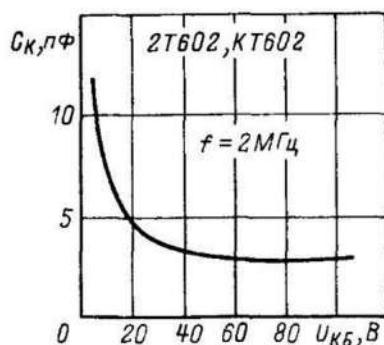
При пайке необходимо осуществлять теплоотвод между корпусом транзистора и местом пайки.



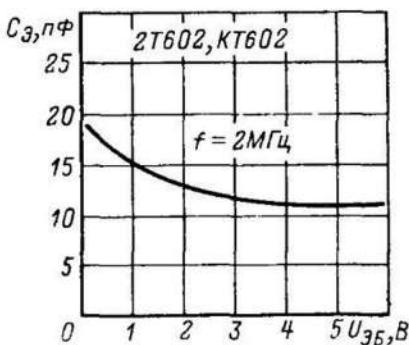
Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры



Зависимость модуля коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база



Зависимость емкости эмиттерного перехода от напряжения эмиттер-база